**[삼성전자] 합격 자기소개서**

**직무 : 연구개발**

**본인의 성장과정 및 지원동기를 기술해 주시기 바랍니다.**

**- 성장과정은 자신에게 가장 큰 영향을 끼친 사건 포함**

**- 지원동기는 회사 및 직무를 선택한 이유, 직무에 필요한 역량을 갖추기 위한 노력, 입사 後 포부 포함**

**(2000자 이내)**

**성장 과정**

[S/W 전 공자 H/W에 도전하다.]

예전부터 반도체 Packaging&Test 회사 A의 전신인 `B`에서 생산관리업무를 담당하셨던 아버지의 영향으로 반도체에 대해 많이 들을 기회가 많았습니다. 컴퓨터 각각의 Device들이 반도체 소자로 구성이 돼 있다는 것을 알게 되었고 하드웨어에 대한 역량을 향상하고 싶어 전자공학과에 편입을 결심했습니다.

주위에선 편입 정말 어렵다. 기본 경쟁률 50:1이라며 만류했습니다. 경쟁률에 의식해서 현실에 안주하기보단 도전하기로 마음을 먹었습니다. 그러나 학교와 편입공부를 병행하는 것은 어려웠습니다. 지난날의 실패 요인들을 철저히 분석했고 실수의 반복을 줄이고자 노력했습니다. 공부 원들을 모집해 하루마다 계획을 세우고 주마다 계획을 점검하면서 치열하게 공부한 결과 S대학교 전자·전기공학부에 진학했습니다.

현실에 안주하기보다는 늘 새로운 것을 지향하는 삼성전자의 가치관은 저의 가치관과 일맥상통한다고 생각합니다. 회사의 이익과 더불어 인류의 삶에 사회적 공헌을 실현하고 싶어 삼성전자 DS 부문에 지원하였습니다.

**지원 동기**

[미래를 창조하는 삼성과 함께하고 싶습니다. ]

스마트폰을 사용하다 보면 사진, 동영상 및 애플리케이션을 저장할 수 있는 공간이 적다 싶었다고 생각했습니다. 앞으로의 메모리 산업은 미세공정 대용량, 저 발열, 고효율이 핵심 추세라고 생각합니다. 이에 삼성전자 메모리사업부는 세계 최고 메모리회사로서 소비자에게 더욱 나은 삶을 제공한다는 점에 공감하였습니다. 학부 때 배웠던 지식과 기술을 접목하여 삼성전자의 연구개발 일원이 되기 위해 다음과 같은 역량을 길러왔습니다.

첫째, 편입 후 물리 전자, 회로이론, 전자회로 등의 수업을 통해 이론이 되는 기본기를 탄탄히 쌓아왔습니다. 에너지 밴드 격차에 따른 PN-Junction, CMOS, DRAM의 구조와 특성에 대해 익혔습니다.

둘째, 회로이론 실험, 전자회로 실험, 논리회로 설계 수강을 통해 실무능력 및 분석력을 키워왔습니다.

전압을 인가함에 따라 RBC 같은 수동소자와 BJT, MOSFET 및 Diode를 변경하면서 납땜을 통해 회로를 구성하고 출력 전압과 전류, 주파수의 수치와 파형을 Oscilloscope를 통해 확인하였습니다. Matlab, PSPICE를 통한 사용 도구들을 익혔고 논리회로 설계를 수강하며 Verilog언어를 익히면서 엔지니어적인 역량을 키워왔습니다.

셋째, 반도체에 대한 호기심입니다.

학부생으로선 공정과정이 지식수준으로 끝나기 때문에 교수님께 자문한 후 석사에게 연구실을 개방해달라고 부탁하여 눈으로 Thin Film Transistor의 증착 과정（CVD, PVD) 과정을 눈으로 직접 확인하고 학부생이 만지기 힘든 Semiconductor Analyzer를 통해 Deposition 과정을 통해 생성된 Thin Film Transistor의 Source와 Drain 전류의 변화를 측정함으로써 원리를 확인했습니다. 또한, 전자신문을 즐겨찾기에 등록해 빠르게 변화하는 IT산업에 추세를 읽고 있습니다.

이러한 역량을 바탕으로 삼성전자 메모리사업부에서 SSD 설계의 전문가가 되어 메모리 공정의 효율의 10% 이상 향상할 수 있는 인재가 되겠습니다.